

Silicon Diode

1N914

75V / 110mA

DATASHEET

OEM – SEL

Source: SEL Databook 1965



Silizium-Planar-Diode

1N914**Ausführung**

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode im Miniatur-Glasgehäuse. Kennzeichnung durch Farbringe — auf der Kathodenseite beginnend — nach dem internationalen Farbcode.

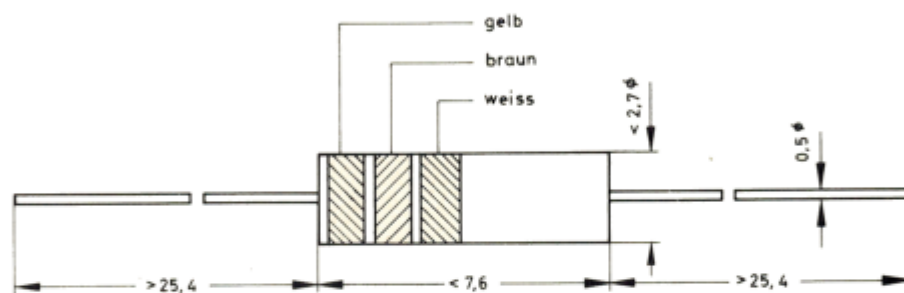
Verwendung

Diode für den Einsatz als sehr schneller Schalter

Abmessungen

(Maße in mm)

Gehäuse DO-7

**Grenzdaten**

Verlustleistung	$T_u = 25\text{ °C}$	P	250	mW
Sperrspannung	$T_u = 25\text{ °C}$	U_R	75	V
Durchlaßgleichstrom		I_F	110	mA
Durchlaßspitzenstrom		I_{FM}	225	mA
Durchlaßstoßspitzenstrom		i_{FS}	500	mA
Maximale Sperrschichttemperatur		$+T_j$	175	°C
Minimale Gehäusetemperatur		$-T_G$	65	°C
Maximale Lagertemperatur		$+T_s$	200	°C
Minimale Lagertemperatur		$-T_s$	65	°C

1N914**Statische Kenndaten bei $T_U = 25\text{ °C}$**

Sperrstrom	$U_R = 20\text{ V}$	I_R	< 25	nA
	$U_R = 75\text{ V}$		< 5	μA
	$U_R = 20\text{ V}$	I_R^*	< 50	μA
Durchlaßstrom	$U_F = 1\text{ V}$	I_F	> 10	mA
Wärmewiderstand	ohne Kühlfläche	R_{thU}	0,5	$^{\circ}\text{C}/\text{mW}$

* $T_U = 150\text{ °C}$ **Dynamische Kenndaten bei $T_U = 25\text{ °C}$**

Diodenkapazität	$U_R = 0\text{ V}$	C	< 4	pF
Sperrverzögerungszeit	von $I_F = 10\text{ mA}$	t_{rr}	< 4	ns

